

[Al-Daffaie S.](#)

5. Publicații la manifestări din RM

5.2. Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1

Teze/Rezumate în culegeri - 2.

2018 - 1

Internal quantum efficiency enhancement of InGaN/GaN LEDs with Mg-Si pin-doped GaN quantum barrier

Kuppers Franko¹, Sirkeli Vadim^{1,2}, Yilmazoglu Oktay¹, Al-Daffaie S.¹, Oprea I.¹, Ong Duusheng³

¹ Institute of Microwave Engineering and Photonics, Technical University of Darmstadt,

² Moldova State University,

³ Multimedia University

Materials Science and Condensed Matter Physics

Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136

Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-797



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.
Actualizat: 01.07.2024, accesat: 02.07.2024
Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

